

Aufgaben zum Tutorium 1

"Elektronische Schaltungen"

SS 2016

Aufgabe 1

Gegeben sei eine Schaltung nach Bild 1.1.

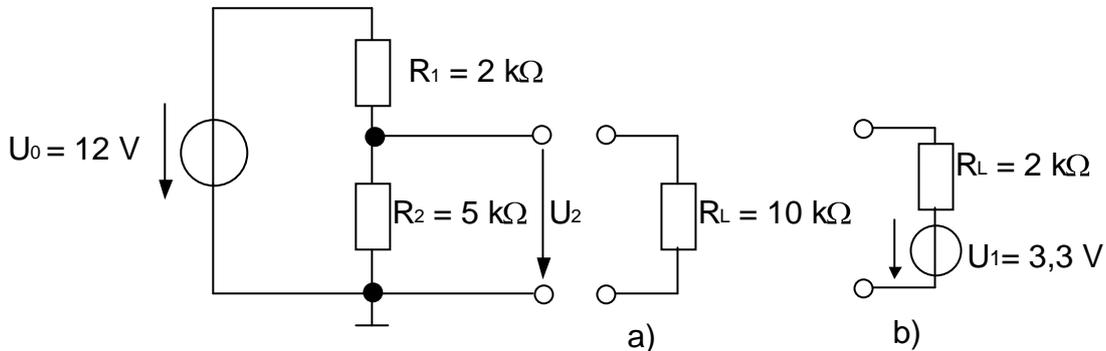


Bild 1.1

- 1.1 Die Schaltung wird im Leerlauf betrieben. Welche Spannung U_2 stellt sich ein?
- 1.2 Parallel zu R_2 wird der Widerstand $R_L = 10 \text{ k}\Omega$ (Fall a) angeschlossen. Welche Spannung U_2 stellt sich jetzt ein?
- 1.3 Parallel zu R_2 wird die Serienschaltung aus dem Widerstand $R_L = 2 \text{ k}\Omega$ und einer Spannungsquelle mit $U_1 = 3,3 \text{ V}$ (Fall b) angeschlossen. Welche Spannung U_2 stellt sich jetzt ein?

Aufgabe 2

Eine Siliziumdiode wird bei einer Temperatur von 0° C betrieben.
($k_B = 1,38 \cdot 10^{-23} \text{ Ws / K}$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ As}$)

- 2.1 Berechnen Sie die Temperaturspannung U_T der Diode !
- 2.2 Der Sättigungsstrom der Diode sei $I_S = 10 \text{ nA}$.
Bestimmen Sie den Widerstand R_D und den differentiellen Widerstand $r_D = dU / dI$ der Diode für die Fälle:
a) $U = U_T$ b) $U = 15 U_T$
- 2.3 **Skizzieren Sie die Strom-Spannungskennlinien der beiden Schaltungen in Bild 2.3a und 2.3b im Durchlass- und im Sperrbereich!**
(Die eingezeichneten Pfeile geben die positive Zählrichtung an. Die beiden Dioden sind Si-Dioden und die beiden Z-Dioden sind vom Typ ZD 3,3)

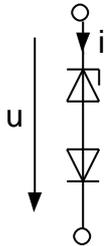


Bild 2.3a

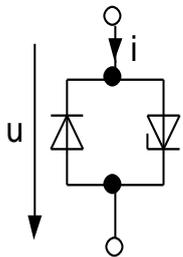
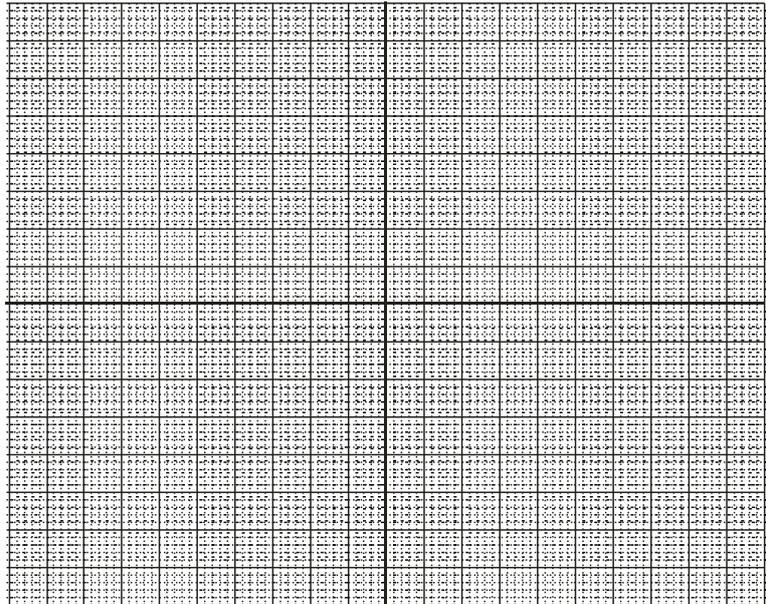
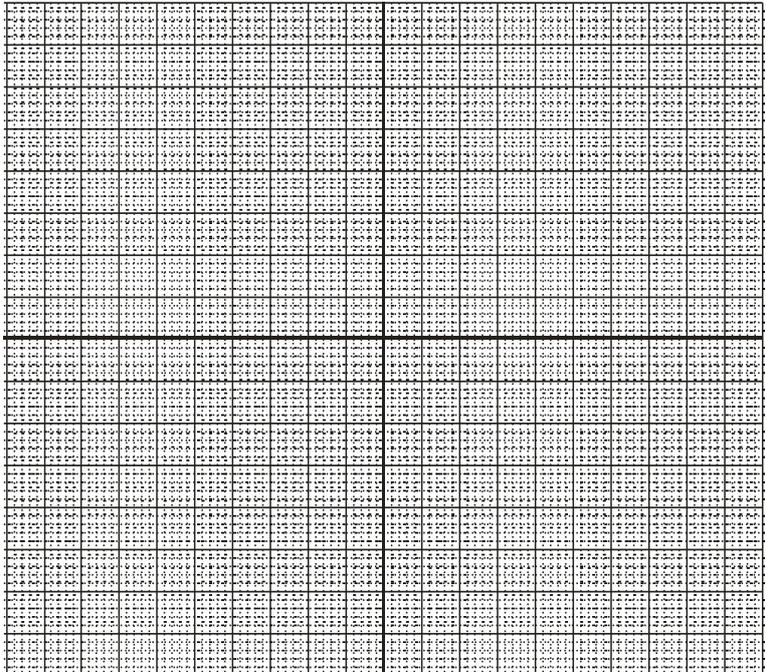


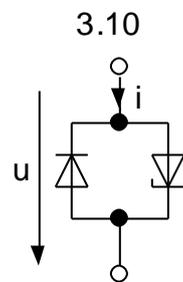
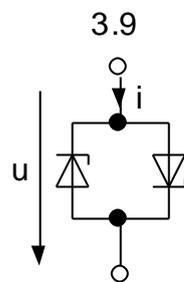
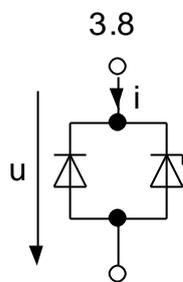
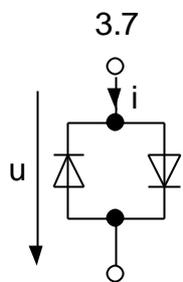
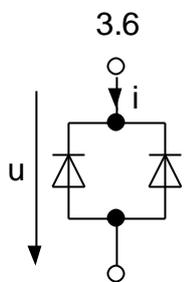
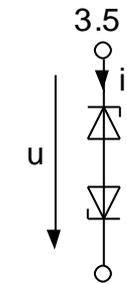
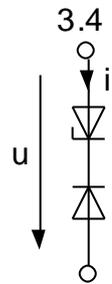
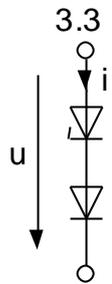
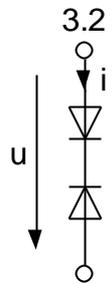
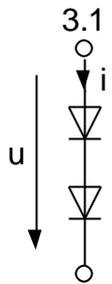
Bild 2.3b



Aufgabe 3

Skizzieren Sie die idealisierten Strom-Spannungskennlinien der Diodenschaltungen 3.1 bis 3.10 im Durchlass und im Sperrbereich! Geben Sie die Werte der auftretenden Knickspannungen an! Die eingezeichneten Pfeile geben die positive Zählrichtung an.

Die Dioden sind alle Si-Dioden und die Z-Dioden sind alle vom Typ ZD 3,3



Aufgabe 4

Gegeben ist eine Schaltung zur Spannungsstabilisierung nach Bild 4.1. Die Strom-Spannungs-Kennlinie der Z-Diode für die eingezeichnete Stromrichtung ist in Bild 4.2 dargestellt.

4.1 Bestimmen Sie graphisch den Arbeitspunkt der Z-Diode für den Fall: $U_0 = 12\text{ V}$,

$$R_V = 2\text{ k}\Omega, R_L = \infty !$$

4.2 Welche Werte müssen R_V und R_L annehmen, wenn $U_0 = 12\text{ V}$ und $I_L = 12\text{ mA}$ sind und der Arbeitspunkt aus 4.1 erhalten bleiben soll?

Welchen Widerstandswert aus der E24-Reihe wählen Sie?

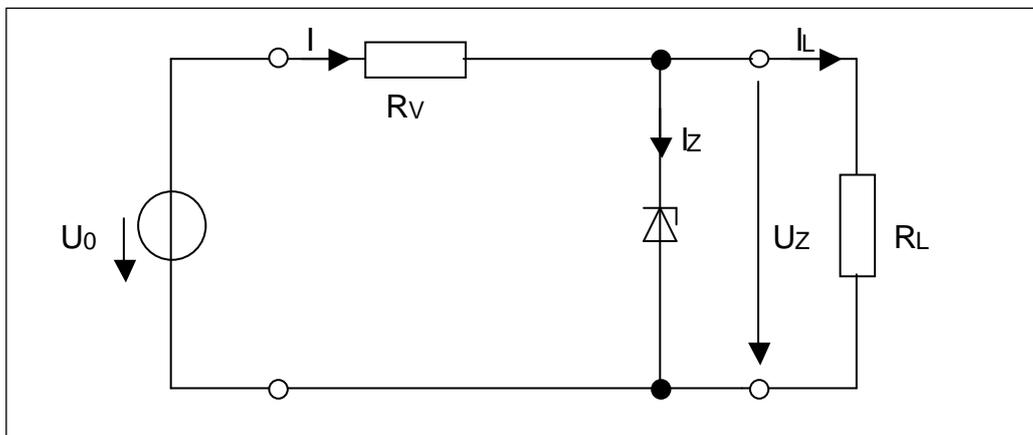


Bild 4.1

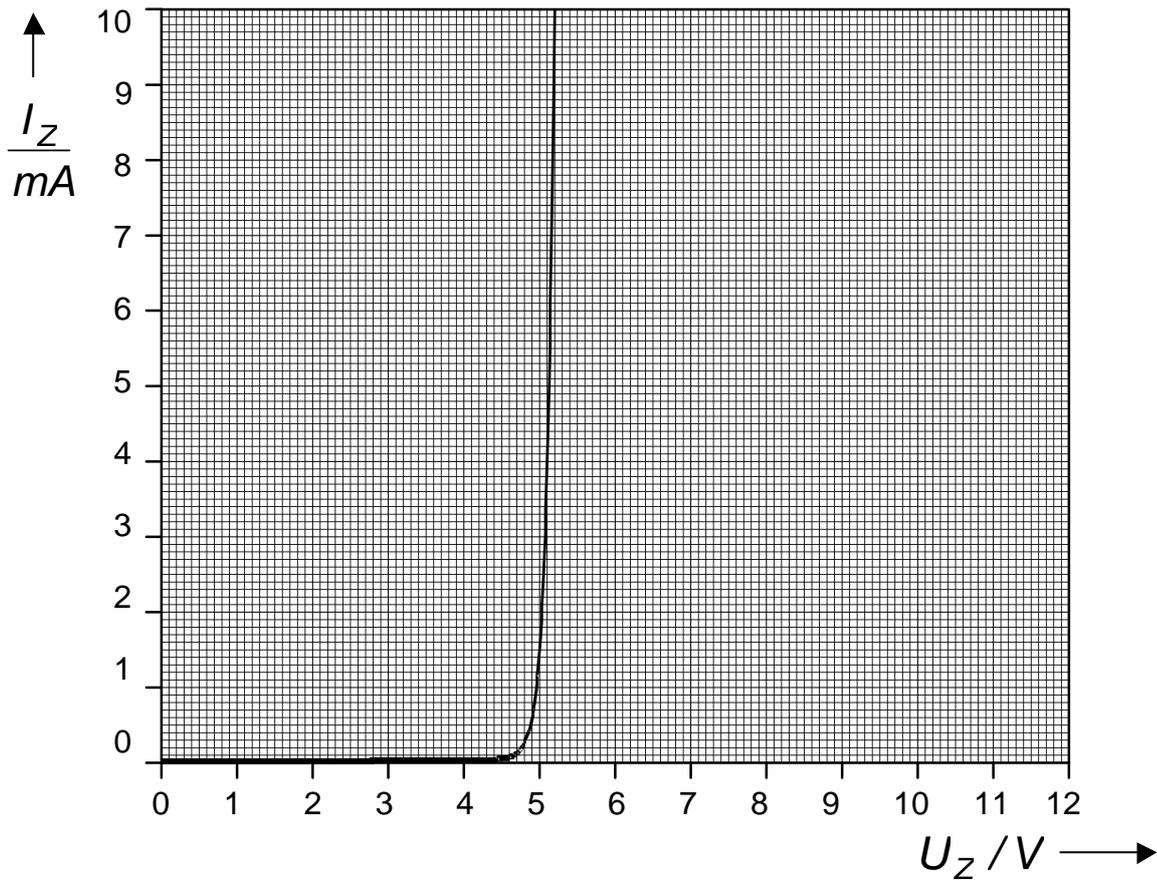


Bild 4.2

Aufgabe 5

Mit einer Schaltung nach Bild 5.1 soll eine Eingangsspannung $u_0 = 9\text{ V} + 2\text{ V} \sin \omega t$ stabilisiert werden. Die Z-Diode habe eine Kennlinie nach Bild 5.2 und $R_V = 620\ \Omega$.

5.1 Ermitteln Sie zeichnerisch die "Restwelligkeit" der Spannung U_Z . Ermitteln Sie dazu die Min-Max Spannungswerte und den Arbeitspunkt ohne überlagerte Sinusschwingung.

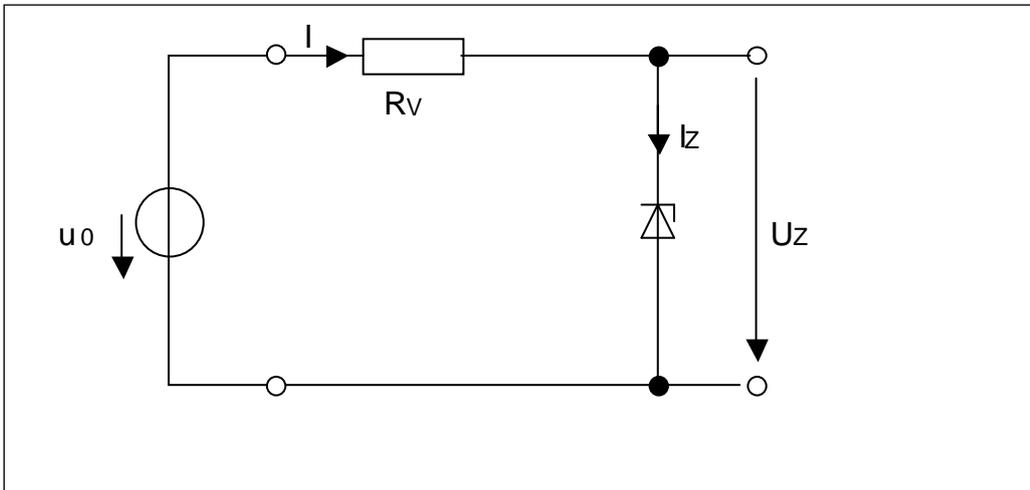


Bild 5.1

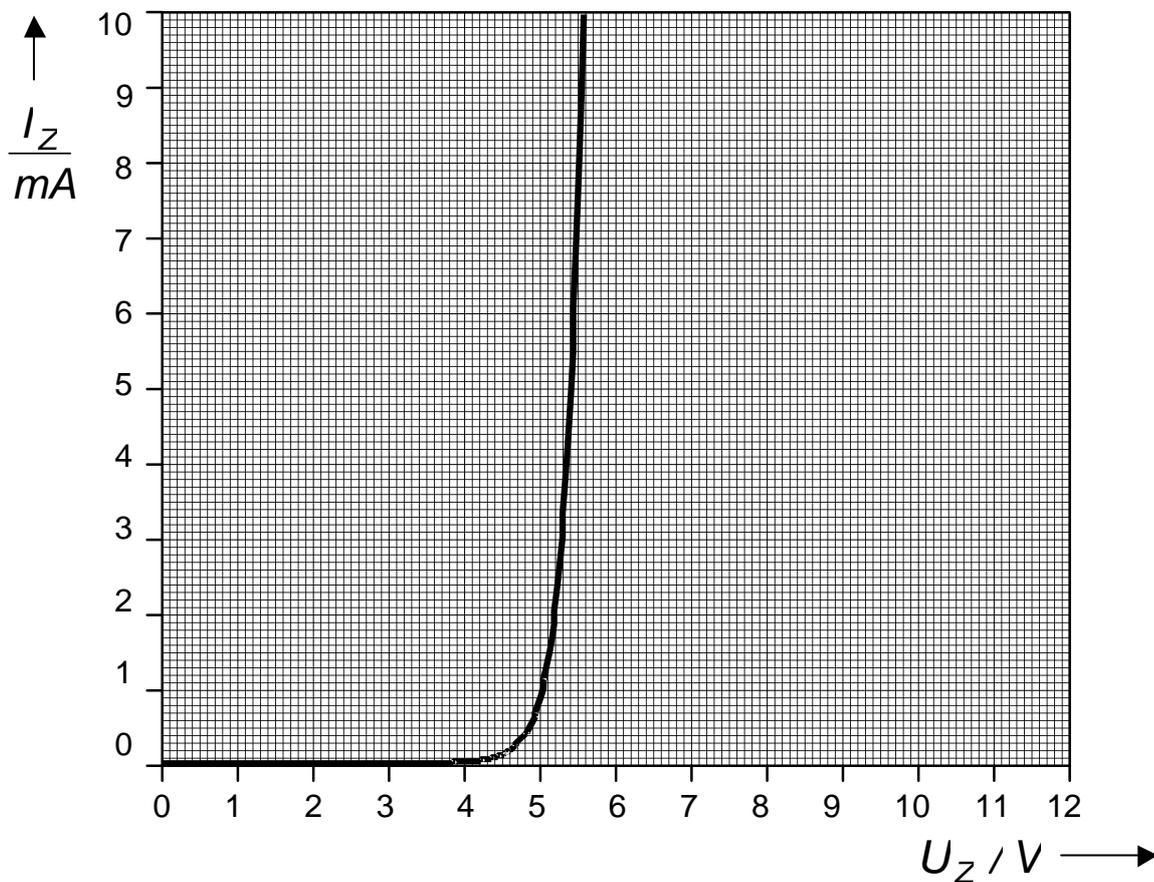


Bild 5.2

Aufgabe 6

Ihre Aufgabe in einem Unternehmen ist es, eine Lichtschranke mit Hilfe eines infraroten Laserstrahls zu realisieren. Zu diesem Zweck soll eine infrarot Laserdiode mit einer bestimmten Signalfolge an und ausgeschalten werden. Als Laserquelle wird eine sogenannte VCSEL Laserdiode verwendet, die die unten angegebenen Parameter besitzt.

Laserdioden benötigen einen Schwellstrom. Das bedeutet, dass unterhalb dieses Stroms die Diode kein Laserlicht abgibt. Die optische Leistung ist ab dem Schwellstrom linear proportional zum Diodenstrom.

- 6.1 Entwerfen Sie einen einfachen Schaltplan, der folgenden Betrieb ermöglicht:
Die Diode soll an einer 12V Quelle betrieben werden und konstant eine optische Leistung von 3 mW abgeben. Orientieren Sie sich zur Arbeitspunktbestimmung an den unten abgebildeten Grafen.
- 6.2 Sie prägen der Diode eine zusätzliche, symmetrische Rechteckspannung auf (direkt über die Diode). Wie groß muss die Spannungsamplitude sein, damit die Diode, die sich im DC-Arbeitspunkt aus a befindet optisch zwischen „An“ und „Aus“ variiert. Die Diode soll nicht unterhalb des Schwellstromes betrieben werden. Wie groß ist die optische Leistung dann im Maximum?

Fig. 1 Typical Power Output vs Forward Current

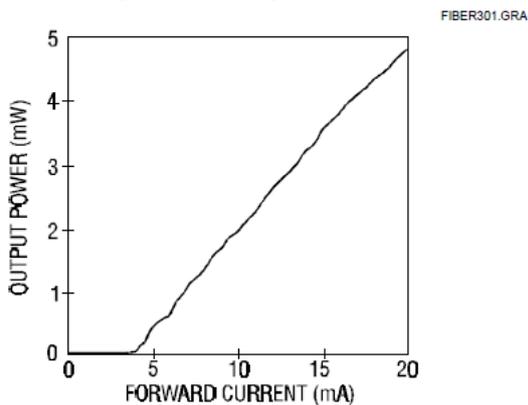


Fig. 2 Typical Threshold Current vs Temperature

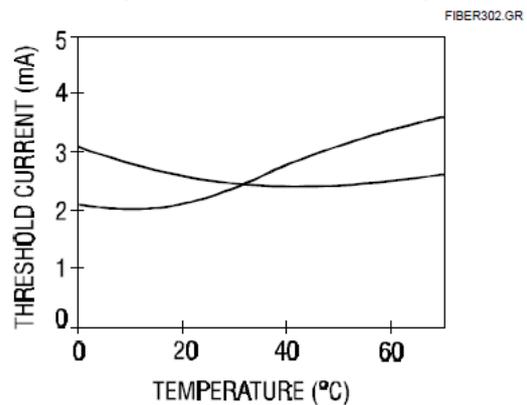


Fig. 3 Typical Spectral Output vs Wavelength

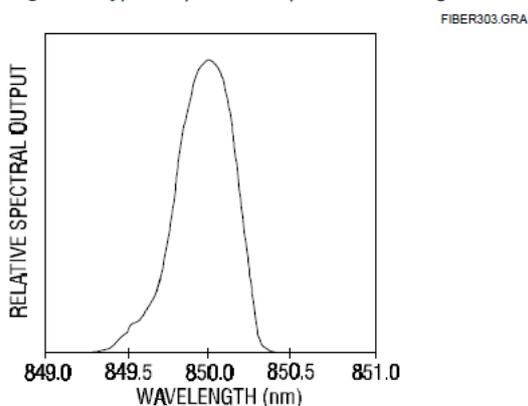
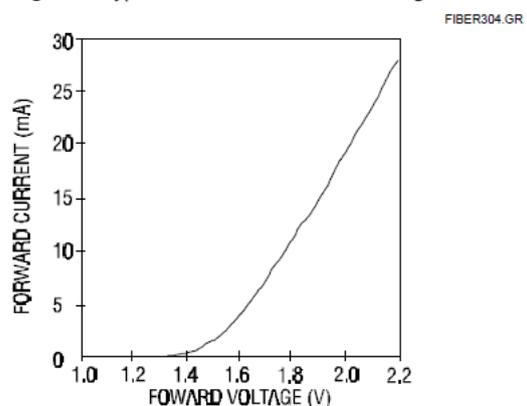


Fig. 4 Typical Current vs Forward Voltage



High Speed Fiber Optic VCSEL

ELECTRO-OPTICAL CHARACTERISTICS (0°C<T<70°C unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	MIN	TYP	MAX	UNITS	TEST CONDITIONS
Output power						
HFE4080-321/XBA	P _O	400	800	1000	μW	I _F = 10 mA ⁽¹⁾
		-4.0	-1.0	0.0	dBm	⁽¹⁾
HFE4080-322/XBA	P _O	800	1000	1500	μW	I _F = 10 mA ⁽¹⁾
		-1.0	0.0	+1.8	dBm	⁽¹⁾
Threshold current	I _{TH}		3.5	6	mA	⁽¹⁾
Slope Efficiency	η		0.3		mW/mA	I _F = 10 mA
Forward Voltage	V _F		1.75	2.20	V	I _F = 10 mA
Reverse Breakdown Voltage	BVR	5.0	10.0		V	I _R = 10 μA
Peak Wavelength	λ _P	820	850	860	nm	I _F = 10 mA DC
Spectral Bandwidth	Δλ		0.5		nm	I _F = 10 mA DC
Rise and fall time	t _R , t _F		100	400	ps	Prebias above threshold, T = 25°C, 10-90%
Analog bandwidth ⁽²⁾						I _F = 10 mA DC
Analog bandwidth ¹	BW		6		GHz	Small signal sinusoidal modulation
Relative Intensity Noise	RIN		-125	-116	dB/Hz	Measured into 1 GHz noise bandwidth
I _{TH} Temperature Coefficient	ΔI _{TH} /ΔT	-0.042	0	.042	mA/°C	I _F = 10 mA
η Temperature Coefficient	Δη/ΔT		-0.001		mW/mA/°C	I _F = 10 mA
P _O Temperature Coefficient	ΔP _O /ΔT		0		dB/°C	I _F = 10 mA
λ _P Temperature Coefficient	Δλ _P /ΔT		0.06		nm/°C	I _F = 10 mA
V _F Temperature Coefficient	ΔV _F /ΔT		-0.2		mV/°C	I _F = 10 mA
Series Resistance	r _S		30.0		Ω	DC
Thermal Resistance	θ _{JA}		900		°C/W	

Notes

1. This product is tested with a 50/125 micron fiber.
2. Packaged components are limited by the electrical parasitics of the package.

Lösungen zum Tutorium 1 in Elektronische Schaltungen

Name:.....Vorname:.....Matr.Nr.:.....

Gruppe:.....

Lösung Aufgabe 1

Lösung Aufgabe 6